

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年7月27日(27.07.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/140345 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/42 (2006.01) *CHID 7/34* (2006.01)
CHID 7/26 (2006.01) *CHID 7/50* (2006.01)
CHID 7/32 (2006.01) *H05K 3/06* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/001641
- (22) 国際出願日: 2023年1月20日(20.01.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-008175 2022年1月21日(21.01.2022) JP
- (71) 出願人: 関東化学株式会社(KANTO KAGAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1030023 東京都中央区日本橋本町3丁目2番8号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 伊藤 翼(ITO, Tsubasa); 〒3400003 埼玉県草加市稲荷1丁目7番1号 関東化学株式会社中央研究所内 Saitama (JP). 佐々木 遼(SASAKI, Ryo); 〒3400003 埼玉県草加市稲荷1丁目7番1号 関東化学株式会社中央研究所内 Saitama (JP). 清水 寿和(SHIMIZU, Toshikazu); 〒3400003 埼玉県草加市稲荷1丁目7番1号 関東化学株式会社中央研究所内 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 葛 和 清 司 (KUZUWA, Kiyoshi); 〒1600023 東京都新宿区西新宿6丁目2番4号 西新宿三井ビルディング17階 葛和国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: PHOTORESIST STRIPPING COMPOSITION

(54) 発明の名称: フォトレジスト剥離組成物

(57) Abstract: The present invention addresses the problem of providing a photoresist stripping composition that exhibits a high stripping performance even with respect to a hardened resist, and that, even when the amount of water in the make-up is small, experiences little decrease in stripping performance when water evaporates and makes it possible to inhibit corrosion of a substrate-constituting metal that comes into contact with a liquid, such as Cu, Al, or Si. The above is accomplished by a photoresist stripping composition containing (A) a quaternary ammonium hydroxide, (B) a sugar alcohol, (C) an amine, (D) water, (E) DMSO, and (F) ethylene glycol, the (D) water content being 1.0-10 mass% relative to the total mass of the composition.

(57) 要約: 本発明は、硬化したレジストに対しても高い剥離性を示し、少量の水を含有する組成であっても、水蒸発時の剥離性の低下が少なく、CuやAlおよびSiなどの接液する基板構成金属の腐食を抑制することのできるフォトレジスト剥離組成物を提供することを課題とする。フォトレジスト剥離組成物であって、組成物が、(A) 四級アンモニウムヒドロキシド、(B) 糖アルコール、(C) アミン、(D) 水、(E) DMSO、および(F) エチレングリコールを含み、(D) 水の含有量が、組成物の全質量に対して1.0~10質量%である組成物により上記課題が達成された。

WO 2023/140345 A1